

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2004 年 6 月 17 日 (17.06.2004)

PCT

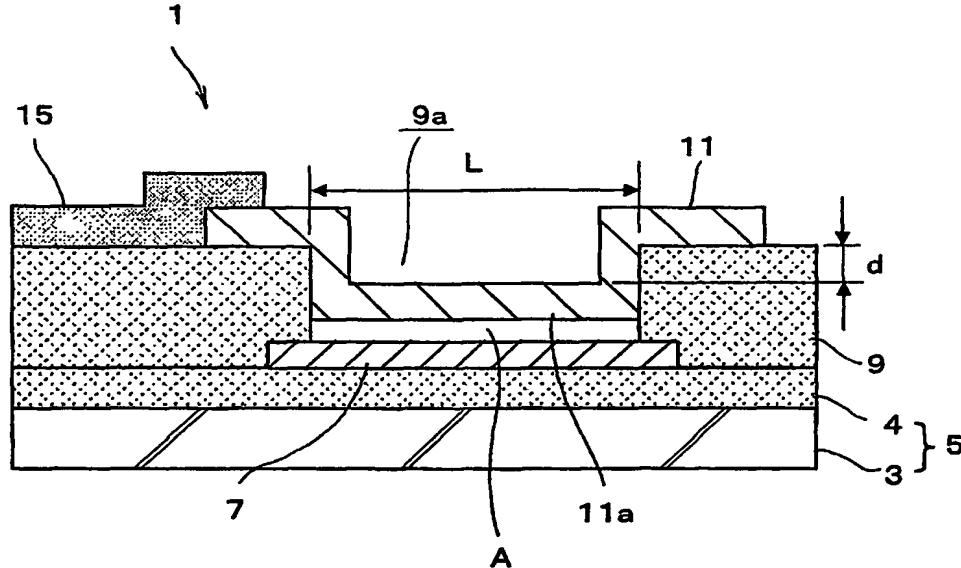
(10) 国際公開番号  
WO 2004/050545 A1

- (51) 国際特許分類: B81B 3/00, B81C 1/00, H03H 9/24 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/014976 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 多田 正裕  
(22) 国際出願日: 2003 年 11 月 25 日 (25.11.2003) (TADA, Masahiro) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区  
(25) 国際出願の言語: 日本語 北品川 6 丁目 7 番 35 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).  
(26) 国際公開の言語: 日本語 木下 隆 (KINOSHITA, Takashi) [JP/JP]; 〒141-0001  
東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35 号 ソニー株式会  
(30) 優先権データ: 特願 2002-350639 2002 年 12 月 3 日 (03.12.2002) JP 社内 Tokyo (JP). 御手洗 俊 (MITARAI, Shun) [JP/JP];  
〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35 号 ソ  
ニー株式会社内 Tokyo (JP). 伊藤 康幸 (ITO, Yasuyuki)  
[JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35  
号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株 (74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA, Tomoyuki); 〒105-  
式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 0001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 番 3 号 虎ノ門第一ビ  
東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35 号 Tokyo (JP). ル 9 階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: MICROMACHINE AND METHOD OF PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: マイクロマシンおよびその製造方法



(57) Abstract: A micromachine for a high frequency filter having a high Q factor and a frequency band which is high. A micro-machine (1) comprising an output electrode (7) disposed on a board (5), an interlayer insulation film (9) covering the board (5) and having a hole pattern (9a) with an output electrode (7) used as a bottom, and a band-like vibrator electrode (11) disposed on the interlayer insulation film (9) in such a manner that, with the interior of the hole pattern (9a) used as a space (A), it crosses the upper region thereof, the micromachine being characterized in that the vibrator electrode (11) is formed as a recess on the hole pattern (9a) side along the side wall of hole pattern (9a).

(57) 要約: Q 値が高く、かつ周波数帯域のより高い高周波フィルタ用のマイクロマシンである。基板 (5) 上に設けられた出力電極 (7) と、基板 (5) を覆う状態で設けられると共に出力電極 (7) を底部とした孔パターン (9a) を備えた層間絶縁膜 (9) と、孔パターン (9a) 内を空間部 (A) としてこの上部を横切るように層間絶縁膜 (9) 上に設けられた帯状の振動子電極 (11)

[続葉有]



(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

)とを備えたマイクロマシン(1)であり、振動子電極(11)は、孔パターン(9a)の側壁に沿って孔パターン(9a)側に凹状に設けられていることを特徴としている。

## 明細書

## マイクロマシンおよびその製造方法

## 5 技術分野

本発明はマイクロマシンおよびその製造方法に関し、特には空間部を介して出力電極上を横切るように振動子電極が設けられたマイクロマシンおよびその製造方法に関する。

## 10 背景技術

基板上における微細加工技術の進展に伴い、シリコン基板、ガラス基板等の基板上に、微細構造体とこの駆動を制御する電極および半導体集積回路等を形成するマイクロマシン技術が注目されている。

その中の一つに、下記非特許文献1 (C.T.-

- 15 C.Nguyen, "Micromechanical components for miniaturized low-power communications(invited plenary)," proceedings, 1999 IEEE MTT-S International Microwave Symposium RF MEMS Workshop, June, 18, 1999, pp. 48-77.) に示すように、無線通信用の高周波フィルタとしての利用が提案されている微小振動子がある。第1
- 20 4図に示すように、微小振動子100は、基板101上に設けられた出力電極102aの上方に、空間部Aを介して振動子電極103を配置してなる。この振動子電極103は、出力電極102aと同一の導電層で構成された入力電極102bに一端部が接続されており、入力電極102bに特定の周波数電圧が印加された場合に、出力電極102a上に空
- 25 間部Aを介して設けられた振動子電極103のビーム(振動部)103aが固有振動周波数で振動し、出力電極102aとビーム(振動部)1

0 3 a との間の空間部 A で構成されるキャパシタの容量が変化し、これが出力電極 1 0 2 a から出力される。このような構成の微小振動子 1 0 0 からなる高周波フィルタは、表面弾性波 (S A W) や薄膜弾性波 (F B A R) を利用した高周波フィルタと比較して、高い Q 値を実現することができる。

このような微小振動子の製造は、次のように行う。まず、第 1 5 A 図に示すように、表面が絶縁膜で覆われた基板 1 0 1 上に、ポリシリコンからなる出力電極 1 0 2 a、入力電極 1 0 2 b、支持電極 1 0 2 c を形成する。これらの電極 1 0 2 a ~ 1 0 2 c は、出力電極 1 0 2 a を挟んだ両側に入力電極 1 0 2 b と支持電極 1 0 2 c とが配置される。次いで、これらの電極 1 0 2 a ~ 1 0 2 c を覆う状態で、基板 1 0 1 上に酸化シリコンからなる犠牲層 1 0 5 を形成する。

次に、第 1 5 B 図に示すように、犠牲層 1 0 5 に、入力電極 1 0 2 b および支持電極 1 0 2 c に達する接続孔 1 0 5 b, 1 0 5 c を形成する。その後、これらの接続孔 1 0 5 b, 1 0 5 c 内を含む犠牲層 1 0 5 上にポリシリコン層 1 0 6 を形成する。

次いで、第 1 5 C 図に示すように、このポリシリコン層 1 0 6 をパターンエッチングすることで、出力電極 1 0 2 a 上を通過する帯状の振動子電極 1 0 3 を形成する。この際、ポリシリコンからなる入力電極 1 0 2 b および支持電極 1 0 2 c のエッチングを防止するために、接続孔 1 0 5 b, 1 0 5 c が完全に覆われるようにポリシリコン層 1 0 6 のパターンエッチングを行う。

以上の後、犠牲層 1 0 5 を選択的に除去し、これによって先の第 1 4 図に示すように、出力電極 1 0 2 a と振動子電極 1 0 3 との間に空間部 A を形成して、微小振動子 1 0 0 を完成させる。

第16図は、上述した構成の微小振動子100のビーム（振動部）103aの長さ（ビーム長）Lと固有振動周波数との関係を示す図である。この図に示すように、下記式（1）に基づく理論上の固有振動周波数（Theory）は、 $(1/L^2)$ に比例する。このため、高周波化を達成するためには、ビーム長Lを縮小する必要がある。

$$f_R = \frac{0.162 h}{L^2} \sqrt{\frac{EK}{\rho}} \quad \dots(1)$$

h : 膜厚  
E : ヤング率  
K : 電磁カップリング率  
 $\rho$  : 膜密度

ところが、上述した微小振動子100においては、出力電極102aを跨ぐ様に空間部Aおよび振動子電極103が設けられるため、出力電極102aの線幅よりもビーム長Lを短くすることはできない。

また、高周波化のためにビーム長Lを微細化しようとした場合、出力電極102aの線幅も微細化する必要があるため、出力電極102aと振動子電極103との間の容量が小さくなり出力が低下してしまう。以上のことは、ビーム長Lの微細化による高周波化の達成を制限する要因になっている。

そこで本発明は、ビーム長の微細化による高周波化をさらに進めることが可能な振動子電極を有するマイクロマシンおよびその製造方法を提供することを目的とする。

このような目的を達成するための本発明のマイクロマシンは振動子電極を備えたものであり、基板上にパターン形成された出力電極を備えており、この出力電極を底部とした孔パターンを備えた層間絶縁膜が基板上に形成されている。また、この層間絶縁膜上には、孔パターン内を空間部としてこの上部を横切るように帯状の振動子電極が設けられている。そして特に、本発明の第1のマイクロマシンは、振動子電極が孔パターンの側壁に沿って当該孔パターン側に凹状に設けられていることを特徴としている。

このような構成の第1のマイクロマシンにおいては、孔パターン上を横切る振動子電極部分が、当該振動子電極のビーム（以下、振動部と記す）となる。このため、出力電極の幅に依存することなく、孔パターンの大きさによって振動部の長さ（すなわちビーム長）が設定され、出力電極の幅よりも短い振動部を有する振動子電極が得られる。しかも、この振動子電極は、その下面が層間絶縁膜の上面で支持されるだけでなく、振動部の側面となる部分が孔パターンの側壁部分によって支持された状態となる。したがって、層間絶縁膜に対する振動子電極の支持が確実となり、振動部のみを振動に寄与させることが可能になる。また、孔パターンの側壁に沿って配置される振動子電極の膜厚分だけ振動部の長さが短縮されるため、実質的な振動部の長さは、孔パターンの開口径よりも短くなる。

また、特に、本発明の第2のマイクロマシンは、孔パターンの両脇に位置する振動子電極の両端部分が、層間絶縁膜とこの上部に設けられた絶縁膜との間に挟持されていることを特徴としている。

このような構成の第2のマイクロマシンにおいては、第1のマイクロマシンと同様に、孔パターン上を横切る振動子電極部分が当該振動子電極の振動部となるため、出力電極の幅よりも短い振動部を有する振動子

電極が得られる。しかも、この振動子電極は、孔パターンの両脇、すなわち振動部の両脇部分が、層間絶縁膜とこの上部に設けられた絶縁膜との間に挟持されているため、層間絶縁膜と絶縁膜とで確実に支持され、振動部のみを振動に寄与させることが可能になる。

- 5      また本発明は、上述した構成の第1のマイクロマシンの製造方法および第2のマイクロマシンの製造方法でもある。

#### 図面の簡単な説明

- 10      第1 A図乃至第1 B図は、第1実施形態のマイクロマシンの断面図および平面図である。

第2 A図乃至第2 D図は、第1実施形態の製造方法を示す断面工程図（その1）である。

第3 A図乃至第3 C図は、第1実施形態の製造方法を示す断面工程図（その2）である。

- 15      第4図は、ビーム長（L）に対する固有振動数のシミュレーション結果を示すグラフである。

第5 A図乃至第5 B図は、第2実施形態のマイクロマシンの断面図および平面図である。

第6図は、第3実施形態のマイクロマシンの断面図である。

- 20      第7 A図乃至第7 D図は、第3実施形態の製造方法を示す断面工程図（その1）である。

第8 A図乃至第8 C図は、第3実施形態の製造方法を示す断面工程図（その2）である。

- 25      第9 A図乃至第9 B図は、第4実施形態のマイクロマシンの断面図および平面図である。

第 10 A 図乃至第 10 D 図は、第 4 実施形態の製造方法を示す断面工程図である。

第 11 図は、第 5 実施形態のマイクロマシンの断面図である。

第 12 A 図乃至第 12 B 図は、第 5 実施形態の製造方法を示す断面工程図である。

第 13 図は、第 6 実施形態のマイクロマシンの断面図である。

第 14 図は、従来のマイクロマシン（微小振動子）の構成を示す図である。

第 15 A 図乃至第 15 C 図は、従来の製造方法を示す断面工程図である。

第 16 図は、従来のマイクロマシンの課題を説明するためのグラフである。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、各実施形態においては、高周波フィルタに好適な微小振動子としてのマイクロマシンの構成およびその製造方法をこの順に説明する。

<第 1 実施形態>

第 1 A 図は第 1 実施形態のマイクロマシンの構成を示す断面図であり、第 1 B 図は第 1 実施形態のマイクロマシンの構成を示す平面図である。尚、第 1 A 図は第 1 B 図の X-X' 断面に相当する。

これらの図に示すマイクロマシン 1 は、半導体基板 3 の表面を絶縁膜 4 で覆ってなる基板 5 上に形成されている。この基板 5 上には、出力電極 7 がパターン形成されている。この出力電極 7 は、マイクロマシン 1 の構成部から引き出されて基板 5 上において配線されている。



また、基板 5 上には、この出力電極 7 を覆う状態で、層間絶縁膜 9 が設けられている。この層間絶縁膜 9 は、出力電極 7 を埋め込む状態で表面平坦に形成されていることが好ましいが、このような形状に限定されることはなく、出力電極 7 の配置に追従した凸部を有する表面形状で、

5 この出力電極 7 を覆うものであっても良い。

このような層間絶縁膜 9 には、出力電極 7 に達する孔パターン 9 a が設けられている。この孔パターン 9 a は、出力電極 7 上からはみ出すことなく、出力電極 7 上のみに配置される。ただし、この孔パターン 9 a の開口径  $L$  は、このマイクロマシン 1 における振動数を決定する因子の

10 1 つとなる。したがって、この孔パターン 9 a は、マイクロマシン 1 で構成される高周波フィルタに必要とされる振動数によって規定された開口径  $L$  で形成されていることとする。

また、層間絶縁膜 9 上には、孔パターン 9 a 内を空間部 A としてこの上部を横切るように帯状の振動子電極 11 が設けられており、空間部 A

15 上、すなわち孔パターン 9 a に重ねて配置された部分が振動部（ビーム）11 a となる。したがって、孔パターン 9 a の開口径  $L$  が、このマイクロマシン 1 の振動部（ビーム）11 a のビーム長  $L$  となる。この振動子電極 11 は、その振動部 11 a が、孔パターン 9 a の側壁に沿って、孔パターン 9 a 側に凹状に設けられている。そして、振動子電極 11 の

20 孔パターン 9 a 側に凹状となる部分（振動部 11 a の中央部分）の表面は、第 1 A 図に示すように、層間絶縁膜 9 の表面よりも任意の値  $d$ （例えば  $d = 0.2 \mu\text{m}$ ）だけ低く設けられていることが好ましい。

また、層間絶縁膜 9 上には、振動子電極 11 に接続された配線 15 が設けられている。尚、配線 15 は、振動子電極 11 と同一層で形成されたものであっても良い。

25

次に、上述した第 1 実施形態のマイクロマシンの製造方法の一例を、第 2 A 図乃至第 2 D 図および第 3 A 図乃至第 3 C 図の断面工程図を用いて詳細に説明する。

5 先ず、第 2 A 図に示すように、単結晶シリコンなどの半導体基板 3 上を絶縁膜 4 で覆ってなる基板 5 を形成する。この絶縁膜 4 は、その最表面が、以降に行われる犠牲層（例えば酸化シリコン）のエッチング除去に対してエッチング耐性を有する材料で構成されることが好ましい。そこで、例えば、半導体基板 3 との間の応力を緩和するための酸化シリコン膜 4 a を介して、上述したエッチング耐性を有する窒化シリコン膜 4 b をこの順に積層してなる絶縁膜 4 を形成することとする。尚、これら  
10 の酸化シリコン膜 4 a および窒化シリコン膜 4 b は、例えば減圧 CVD 法によって形成される。

次に、第 2 B 図に示すように、基板 5 上に第 1 導電層をパターニングしてなる出力電極 7 を形成する。この出力電極 7 を構成する第 1 導電層  
15 は、例えばリン（P）を含有するポリシリコン等のシリコン層であることとする。なお、第 1 電極層のパターニングおよび以下に示す各構成部のパターン形成は、リソグラフィ処理で形成したレジストパターンをマスクにして材料膜をエッチングすることによって行われることとする。

その後、第 2 C 図に示すように、出力電極 7 を覆う状態で、基板 5 上  
20 を層間絶縁膜 9 で覆う。この際、例えば、出力電極 7 が埋め込まれるように基板 5 上に出力電極 7 の膜厚よりも厚い膜厚で層間絶縁膜 9 を形成し、この層間絶縁膜 9 の表面を平坦化することが好ましい。この層間絶縁膜 9 は、後に行われる犠牲層のエッチング除去に対してエッチング耐性を有する絶縁性材料からなることとする。この際、例えば上述した犠  
25 牲層を酸化シリコンで形成する場合には、窒化シリコンからなる層間絶縁膜 9 を形成することとする。尚、層間絶縁膜 9 は、表面平坦に出力電

極 7 を埋め込むように形成される必要はなく、出力電極 7 の配置に追従した表面形状を有して当該出力電極 7 を覆う様に形成されても良い。また、窒化シリコンからなる層間絶縁膜 9 は、例えば減圧 CVD 法によって形成される。

- 5      次いで、この層間絶縁膜 9 に、出力電極 7 に達する孔パターン 9 a を形成する。この孔パターン 9 a は、上述したように、完全に出力電極 7 上のみに配置されるような開口形状で形成されることとし、これにより、孔パターン 9 a の底部を出力電極 7 とする。

- 次いで、第 2 D 図に示すように、孔パターン 9 a の底部に露出している出力電極 7 の表面を犠牲層 10 で覆う。この犠牲層 10 は、層間絶縁膜 9 および出力電極 7 に対して選択的に除去が可能な材料、例えば酸化シリコンで構成されることとする。この場合、例えば窒化シリコンからなる層間絶縁膜 9 をマスクにしてポリシリコンからなる出力電極 7 の表面を酸化させ、これにより出力電極 7 の露出表面を酸化シリコンからなる犠牲層 10 で覆う。またここでは、犠牲層 10 の表面が、層間絶縁膜 9 の表面よりも十分に低くなるように、すなわち犠牲層 10 形成後にも孔パターン 9 a 部分が凹状に維持されるように、犠牲層 10 の形成を行うことが重要である。
- 10
- 15

- 以上の後、第 3 A 図に示すように、底部が犠牲層 10 で覆われた孔パターン 9 a の内壁を覆う状態で、層間絶縁膜 9 上に第 2 導電層 12 を成膜する。この第 2 導電層 12 は、以降に行われる犠牲層 10 のエッチングに対して耐性を有する材料からなることとする。このため、犠牲層 10 が酸化シリコンからなる場合には、第 2 導電層 12 は例えばポリシリコン膜で構成されることとする。また、この第 2 導電層 12 において、孔パターン 9 a 側に凹状となる部分の表面が、層間絶縁膜 9 の表面よりも低くなるように、当該第 2 導電層 12 の膜厚が設定されることとする。
- 20
- 25

次いで、第 3 B 図に示すように、第 2 導電層 12 をパターンニングすることで、犠牲層 10 および層間絶縁膜 9 上に振動子電極 11 をパターン形成する。この振動子電極 11 は、犠牲層 10 を横切り、孔パターン 9 a の一部および孔パターン 9 a 内に形成された犠牲層 10 の一部を露出する帯状にパターン形成されることとする。この場合、例えば第 1 B 図に示したように、振動子電極 11 の両脇から、孔パターン 9 a を露出させても良い。また、振動子電極 11 の幅 W 方向（ビーム長 L と垂直な方向）の片側からのみ、孔パターン 9 a および犠牲層 10 を露出させても良い。

- 次に、第 3 C 図に示すように、振動子電極 11 に接続する配線 15 を層間絶縁膜 9 上に形成する。この配線 15 を形成する場合には、例えば先ず、基板 5 上の全面に金（Au）のシード層（図示省略）を形成した後、配線を形成する部分を露出させて他の部分を覆うレジストパターン（図示省略）を形成する。次いで、メッキ法によりレジストパターンの開口部内のシード層上にメッキ層を成長させて配線 15 を形成する。配線 15 形成後には、レジストパターンを除去し、さらにシード層を除去するための全面エッチングを行う。尚、この配線 15 を、振動子電極 11 と同一層で構成する場合には、この工程を行う必要はない。

- 以上の後、配線 15、振動子電極 11、層間絶縁膜 9 および出力電極 7 に対して選択的に犠牲層 10 をエッチング除去する。この際、パuffers ードフッ酸を用いたウェットエッチングを行うことで、振動子電極 11 下の酸化シリコンからなる犠牲層 10 を確実に除去する。

- これにより、第 1 A 図及び第 1 B 図に示すように、振動子電極 11 の下部に犠牲層を除去してなる空間部 A を形成すると共に、孔パターン 9 a 底部の出力電極 7 を露出させる。そして、孔パターン 9 a 内を空間部

Aとしてこの上部を横切るように、層間絶縁膜 9 上に帯状の振動子電極 11 を設けてなるマイクロマシン 1 を得る。

以上説明した構成の第 1 実施形態のマイクロマシン 1 においては、層間絶縁膜 9 に形成された孔パターン 9 a 内を空間部 A として、この上部を横切るように振動子電極 11 が配置されている。このため、特定の周波数の電圧を印可して振動子電極 11 を振動させた場合、孔パターン 9 a 上を横切る振動子電極 11 部分が振動し、この部分が振動子電極 11 のビーム（振動部）11 a となる。したがって、孔パターン 9 a の大きさによって、振動部 11 a の長さ（ビーム長 L）が設定されることになる。

このため、第 1 4 図を用いて説明したような、出力電極 102 a を跨ぐように空間部 A および振動子電極 103 が配置される従来の構成のマイクロマシンにおいては、振動子電極 103 のビーム長 L を出力電極 102 a の最小加工寸法よりも小さくすることはできなかったが、第 1 A 図乃至第 1 B 図に示した本第 1 実施形態のマイクロマシン 1 においては、出力電極 7 の線幅によらず、振動子電極 11 のビーム長 L を孔パターン 9 a の最小加工寸法にまで縮小することが可能になる。したがって、さらなるビーム長 L の微細化と、これによる高周波化の達成が可能となる。

また、振動子電極 11 と出力電極 7 との間に生じる容量を、従来の構成のマイクロマシン（第 1 4 図参照）と本第 1 実施形態のマイクロマシン 1 とで比較した場合、本第 1 実施形態のマイクロマシン 1 のほうが、振動子電極 11 と出力電極 7 との対向面積をビーム長 L に対して広くすることができるため、ビーム長 L に対する容量を大きくすることができる。したがって、高周波化を目的としてビーム長 L を微細化した場合であっても、出力を維持することが可能になる。

そして特に、本第 1 実施形態の構成のマイクロマシン 1 においては、振動子電極 1 1 の両端部、すなわち振動部 1 1 a を支持するアンカー部分が、その全面にわたって層間絶縁膜 9 に対して固定されているだけではなく、振動部 1 1 a の側面が孔パターン 9 a の側壁部分によって支持された状態となっている。したがって、層間絶縁膜 9 に対する振動子電極 1 1 の支持が確実となり、振動部 1 1 a のみを効率良く振動に寄与させることが可能になる。この結果、所定周波数の電圧を印可して振動子電極 1 1 を振動させた場合、ビーム（振動部）1 1 a のみが振動に関与して振動することになる。したがって、固有振動周波数が、上述した式（1）を満たす理論上の値（振動部の長さ L の二乗に反比例した値）により近くなる。このことから、微細化による高周波化の達成が容易になると言える。

またさらに、このマイクロマシン 1 の振動子電極 1 1 は、孔パターン 9 a の側壁に沿って配置される振動子電極 1 1 の膜厚分だけ振動部 1 1 a の長さが短縮される。このため、実質的に振動する振動部分の長さは、孔パターン 9 a の開口幅よりも短くなる。このことから、高周波化の達成が容易となっている。

第 4 図には、各構成のマイクロマシンにおける、固有振動数のビーム長 L 依存性のシミュレーション結果の図を示す。この図に示すように、第 1 実施形態のマイクロマシンにおいては、固有振動数のビーム長依存性が、上述した式（1）を満たす理論上の値（Theory）により近くなり、微細化による高周波化の達成が容易になることが確認された。

これに対して、第 1 4 図に示した従来構造のマイクロマシンにおいては、製造工程上の都合から、ビーム（振動部）1 0 3 a を支持するアンカー部分の先端が、下地に密着しない底部 B が形成されるため、この底部 B が、ビーム（振動部）1 0 3 a の振動に対して影響を及ぼしていた。

このため、ビーム長 $L$ が微細化された領域においては、固有振動周波数が、上述した式(1)を満たす理論上の値を下回り、ビーム長 $L$ の微細化による高周波化が困難であった。

5 以上の結果、本構成のマイクロマシン1を用いることで、 $Q$ 値が高くかつ周波数帯域のより高い高周波フィルタを実現することが可能になる。

また特に、出力電極7を埋め込む層間絶縁膜9の表面を平坦に形成した場合、層間絶縁膜9を介して出力電極7と振動子電極11との間に生じる寄生容量(振動に寄与しない部分の容量)を最小限に抑えることができる。このため、このマイクロマシン1からなる高周波フィルタにおいて、周波数の選択性(透過特性)の向上を図ることも可能になる。

尚、上述した第1実施形態においては、第1B図に示したように、振動子電極11の線幅 $W$ が同一である場合を説明したが、振動子電極11は層間絶縁膜9上に配置された両端部に線幅の大きな部分が設けられた形状であっても良く、このような形状とすることで、さらにビーム(振動部)11aの支持を確実にすることが可能になる。

#### <第2実施形態>

第5A図は第2実施形態のマイクロマシンの構成を示す断面図であり、第5B図は第2実施形態のマイクロマシンの構成を示す平面図である。

尚、第5A図は第5B図の $X-X'$ 断面に相当する。

20 これらの図に示す第2実施形態のマイクロマシン20と、第1実施形態において第1A図乃至第1B図を用いて説明したマイクロマシンとの異なるところは、振動子電極11'の構成にあり、他の構成は同様であることとする。

すなわち、これらの第5A図、第5B図に示すマイクロマシン20の振動子電極11'は、層間絶縁膜9に形成された孔パターン9a内を空間部Aとしてこの空間部Aを塞ぐような幅 $W$ で設けられており、かつ空

間部Aに達する孔部11bを有している。そして、このような振動子電極11'では、空間部A上、すなわち孔パターン9aに重ねて配置された部分が振動部11a'となることは、第1実施形態と同様である。

ここで孔部11bは、図示したように、振動子電極11'に1箇所設けられても良いし、2箇所以上の複数箇所設けられても良い。ただし、孔部11bの開口面積率（孔パターン9aに対する）および配置状態（個数も含む）は、本第2実施形態のマイクロマシン20を高周波フィルタとして用いた場合に、目的とする周波数帯域の出力が得られる様に適宜設定されることとする。

また第1実施形態と同様に、この振動子電極11'は、その振動部11a'が、孔パターン9aの側壁に沿って、孔パターン9a側に凹状に設けられていることとし、さらに、振動子電極11'の孔パターン9a側に凹状となる部分（振動部11a'の中央部分）の表面が層間絶縁膜9の表面よりも任意の値（d）だけ低く設けられていることが好ましい。

このような構成の振動子電極11'を備えたマイクロマシン20を製造する場合には、第1実施形態のマイクロマシンの製造方法において、第3B図を用いて振動子電極をパターン形成する工程で、孔パターン9aを覆うと共に孔パターン9a内の犠牲層10に達する孔部を有する振動子電極を形成し、次にこの孔部を介して犠牲層10を選択的に除去すると言った方法が採用される。

以上、第5A図乃至第5B図を用いて説明した構成の第2実施形態のマイクロマシン20においては、孔パターン9a内を空間部Aとして、この上部を塞ぐように振動子電極11'が配置され、振動子電極11'には空間部Aに連通する孔部11bが設けられている。このため、特定周波数の電圧を印可して振動子電極11'を振動させた場合、孔パターン9aを塞ぐ振動子電極11'部分が振動し、この部分が振動子電極1



1' の振動部 11a' となる。したがって、孔パターン 9a の大きさによって、振動部 11a' のビーム長 L が設定されることになる。このため、第 1 実施形態のマイクロマシンと同様に、出力電極 7 の線幅に依存することなく、孔パターン 9a の大きさによってビーム長 L を設定することが可能となる。この結果、ビーム長 L の微細化による高周波化の達成、および出力の維持を達成することが可能になる。

特に、本第 2 実施形態のマイクロマシン 20 は、振動子電極 11' によって孔パターン 9a が塞がれるため、ビーム（振動部）11a' が全周にわたって層間絶縁膜 9 に支持固定された状態となっており、しかも、振動子電極 11' の両端部、すなわちビーム（振動部）11a' を支持するアンカー部分が、その全面にわたって層間絶縁膜 9 に対して固定されているだけではなく、振動部 11a' の側面が孔パターン 9a の側壁部分によって支持された状態となっている。このため、第 1 実施形態のマイクロマシンと比較して振動子電極 11' の支持状態がさらに確実に  
なり、固有振動周波数をさらに上昇させることが可能である。

### <第 3 実施形態>

第 6 図は第 3 実施形態のマイクロマシンの構成を示す断面図である。この図に示す第 3 実施形態のマイクロマシン 30 と、第 1 実施形態において第 1 A 図乃至第 1 B 図を用いて説明したマイクロマシンとの異なるところは、層間絶縁膜 31 の構成にあり、他の構成は同様であることとする。

すなわち、このマイクロマシン 30 は、出力電極 7 を覆う状態で基板 5 上に設けられた層間絶縁膜 31 が、第 1 層 32 とその上部の第 2 層 33 との 2 層で構成されている。

このうち、第 1 層 32 は、出力電極 7 を埋め込むために十分な膜厚を有していることとする。この第 1 層 32 は、表面平坦に形成されている

ことが好ましいが、このような形状に限定されることはなく、出力電極 7 の配置に追従した凸部を有する表面形状で当該出力電極 7 を覆うものであっても良い。そして、この第 1 層 3 2 には、出力電極 7 に達する孔パターン 3 2 a が設けられている。この孔パターン 3 2 a は、出力電極 7 上からはみ出すことなく、出力電極 7 上のみ配置されることが好ましいが、これに限定されることはない。

また、第 2 層 3 3 は、第 1 層 3 2 よりも十分に薄い膜厚を有し、第 1 層 3 2 の孔パターン 3 2 a の内壁に沿ってこれを覆う状態で、第 1 層 3 2 上に設けられている。また、第 2 層 3 3 の膜厚は、第 1 層 3 2 を保護でき、かつ振動子電極 1 1 の下部に配置される空間部 A の高さと同程度かこれよりも厚いこととする。そして、この第 2 層 3 3 には、出力電極 7 に達する孔パターン 3 3 a が設けられている。この孔パターン 3 3 a は、第 1 層 3 2 の孔パターン 3 2 a の内側に形成され、出力電極 7 上からはみ出すことなく出力電極 7 上のみ配置され、かつ第 1 層 3 2 が露出することのないように設けられることとする。また、出力電極 7 上は、所定幅（長さ）の第 2 層 3 3 部分で覆われることとする。

そして、これらの第 1 層 3 2 および第 2 層 3 3 で構成された層間絶縁膜 3 1 上に設けられた振動子電極 1 1 は、第 2 層 3 3 を介して第 1 層 3 2 の孔パターン 3 2 a の側壁に沿って配設されることで、孔パターン 3 2 a 側に凹状に設けられている。また、振動子電極 1 1 は、第 2 層 3 3 の孔パターン 3 3 a 内を空間部 A として、この空間部 A を横切る状態で設けられている。このため、空間部 A 上、すなわち孔パターン 3 3 a に重ねて配置された部分が振動部（ビーム）1 1 a となる。

ここで、振動子電極 1 1 は、第 2 層 3 3 の孔パターン 3 3 a の側壁に沿って、孔パターン 3 3 a 側（すなわち空間部 A 側）に凹状に設けられても良い。この場合、振動子電極 1 1 は、出力電極 7 側に向かう 2 段階

の凹状に構成される。このため、振動部 1 1 a の側面側が、階段状に支持された状態となる。尚、振動部 1 1 a の中央部分の表面が層間絶縁膜 3 1 (第 2 層 3 3) の表面よりも任意の値 (d) だけ低く設けられていることが好ましいことは、第 1 実施形態と同様である。

- 5      次に、上述した第 3 実施形態のマイクロマシンの製造方法の一例を、第 7 A 図乃至第 7 D 図および第 8 A 図乃至第 8 C 図の断面工程図を用いて詳細に説明する。

先ず、第 7 A 図に示すように、半導体基板 3 上を絶縁膜 4 で覆ってなる基板 5 を形成し、この上部に出力電極 7 を形成するまでを、第 1 実施  
10    形態で第 2 A 図および第 2 B 図を用いて説明したと同様に行う。

次に、第 7 B 図に示すように、出力電極 7 を覆う状態で、基板 5 上を層間絶縁膜の第 1 層 3 2 で覆う。この際、例えば、出力電極 7 が埋め込まれるように基板 5 上に出力電極 7 の膜厚よりも厚い膜厚で第 1 層 3 2 を形成し、この第 1 層 3 2 の表面を平坦化することが好ましい。この第  
15    1 層 3 2 は、例えば酸化シリコンを用いて形成されることとする。その後、この第 1 層 3 2 に、出力電極 7 に達する孔パターン 3 2 a を形成する。

次いで、第 7 C 図に示すように、第 1 層 3 2 の孔パターン 3 2 a の内壁を覆う状態で、第 1 層 3 2 よりも十分に膜厚の薄い第 2 層 3 3 を形成  
20    する。この第 2 層 3 3 は、後に行われる犠牲層のエッチング除去に対してエッチング耐性を有する絶縁性材料からなることとする。この際、例えば上述した犠牲層を酸化シリコンで形成する場合には、窒化シリコンからなる第 2 層 3 3 を形成することとする。

そして、この第 2 層 3 3 に、出力電極 7 に達する孔パターン 3 3 a を  
25    形成する。この孔パターン 3 3 a は、上述したように、完全に出力電極

7上のみに配置されるような開口形状で形成されることとし、これにより、孔パターン33aの底部を出力電極7とする。

5 以上の後、第7D図に示すように、孔パターン33aの底部に露出している出力電極7の表面を犠牲層10で覆う。この犠牲層10は、第2層33および出力電極7に対して選択的に除去が可能な材料、例えば酸化シリコンで構成されることとする。この場合、この犠牲層10は、第1実施形態において第2D図を用いて説明したと同様に形成する。またここでは、犠牲層10の表面が、第2層33の表面と同程度かそれよりも低くなるように犠牲層10の形成を行うことが重要である。

10 その後、第8A図～第8C図に示す工程は、第1実施形態において第3A図乃至第3C図を用いて説明したと同様に行う。ただし、第8C図に示す工程で、犠牲層10を除去する場合には、配線15、振動子電極11、第2層33および出力電極7に対して選択的に犠牲層10をエッチング除去することとする。

15 以上により、第6図に示すように、振動子電極11の下部に犠牲層を除去してなる空間部Aを形成すると共に、孔パターン33a底部の出力電極7を露出させる。そして、孔パターン33a内を空間部Aとしてこの上部を横切るように、第2層33上に帯状の振動子電極11を設けてなるマイクロマシン30を得る。

20 以上説明した第3実施形態のマイクロマシン30においては、孔パターン33a内を空間部Aとして、この上部を横切るように振動子電極11が配置されており、また振動子電極11のビーム（振動部）11aの側面が孔パターン32a、33aの側壁部分に支持された状態となっている。このため、第1実施形態のマイクロマシンと同様に、Q値が高く、  
25 かつ周波数帯域のより高い高周波フィルタを実現することが可能になる。

＜第4実施形態＞

第 9 A 図は第 4 実施形態のマイクロマシンの構成を示す断面図であり、第 9 B 図は第 4 実施形態のマイクロマシンの構成を示す平面図である。尚、第 9 A 図は第 9 B 図の X-X' 断面に相当する。

これらの図に示す第 4 実施形態のマイクロマシン 40 と、第 1 実施形態において第 1 A 図乃至第 1 B 図を用いて説明したマイクロマシンとの異なるところは、出力電極 7' が溝配線として構成されている点にあり、他の構成は同様であることとする。

すなわち、これらの第 9 A 図、第 9 B 図に示すマイクロマシン 40 の出力電極 7' は、層間絶縁膜 9' に形成された孔パターン 9 a' 内に溝配線として設けられており、層間絶縁膜 9' から出力電極 7' の上面全体が露出された状態となっている。このため、層間絶縁膜 9' に形成された孔パターン 9 a' は、出力電極 7' から引き出された配線部分も露出させるような溝配線パターンとして形成されていることとする。

次に、上述した第 4 実施形態のマイクロマシンの製造方法の一例を、第 10 A 図乃至第 10 D 図および第 11 図の断面工程図を用いて詳細に説明する。

先ず、第 10 A 図に示すように、半導体基板 3 上を絶縁膜 4 で覆ってなる基板 5 を形成するまでを、第 1 実施形態で第 2 A 図を用いて説明したと同様に行う。

次に、第 10 B 図に示すように、基板 5 上に層間絶縁膜 9' を形成し、この層間絶縁膜 9' に基板 5 (絶縁膜 4) に達する溝配線用の孔パターン 9 a' を形成する。

その後、第 10 C 図に示すように、孔パターン 9 a' 内に出力電極 7' を形成する。ここでは、例えば、孔パターン 9 a' 内を埋め込むように、出力電極 7' を構成する第 1 導電層 (ポリシリコン層) を層間絶縁膜 9' 上に形成し、次いで層間絶縁膜 9' 上の第 1 導電層を CMP に

より研磨除去する。しかる後、孔パターン 9 a' 内の第 1 導電層をエッチバックすることで、当該第 1 導電層からなる出力電極 7' を、層間絶縁膜 9' よりも十分に低い膜厚で形成する。

- 次いで、第 10 D 図に示すように、出力電極 7' の露出表面上に選択的に犠牲層 10 を形成する。この工程は、第 1 実施形態において第 2 D 図を用いて説明したと同様に行う。そして、その後の工程は、第 1 実施形態において第 3 A 図乃至第 3 C 図を用いて説明したと同様に行い、これにより、第 9 A 図乃至第 9 B 図を用いて説明した構成のマイクロマシン 40 を得る。
- 10 以上説明した第 4 実施形態のマイクロマシン 40 であっても、孔パターン 9 a' 内を空間部 A として、この上部を横切るように振動子電極 11 が配置されており、また振動子電極 11 のビーム（振動部）11 a の側面が孔パターン 9 a' の側壁部分に支持された状態となっている。このため、第 1 実施形態のマイクロマシンと同様に、Q 値が高く、かつ周波数帯域のより高い高周波フィルタを実現することが可能になる。
- 15

#### <第 5 実施形態>

- 第 11 図は第 5 実施形態のマイクロマシンの構成を示す断面図である。この図に示す第 5 実施形態のマイクロマシン 50 と、第 1 実施形態において第 1 A 図乃至第 1 B 図を用いて説明したマイクロマシンとの異なる
- 20 ところは、振動子電極 11 を覆う状態で層間絶縁膜 9 上に絶縁膜 51 が設けられている点にあり、他の構成は同様であることとする。

- すなわち、このマイクロマシン 50 においては、層間絶縁膜 9 上に支持されている振動子電極 11 部分、すなわち振動子電極 11 における振動部 11 a の両脇部分が、層間絶縁膜 9 とこの上部の絶縁膜 51 との間に挟持されている。また、配線 15 も、層間絶縁膜 9 と絶縁膜 51 との間に挟持される。
- 25

ここで、層間絶縁膜 9 上に積層された絶縁膜 5 1 は、層間絶縁膜 9 の孔パターン 9 a を第 1 孔パターン 9 a とした場合、この第 1 孔パターン 9 a とほぼ同じ位置に略同一形状の第 2 孔パターン 5 1 a を有していることとする。尚、この第 2 孔パターン 5 1 a は、振動子電極 1 1 における振動部 1 1 a の振動を妨げるもののない大きさであれば良い。

次に、上述した第 5 実施形態のマイクロマシンの製造方法の一例を、第 1 2 A 図乃至第 1 2 B 図の断面工程図を用いて詳細に説明する。

先ず、第 1 実施形態で第 2 A 図乃至第 2 D 図および第 3 A 図乃至第 3 C 図を用いて説明したと同様の手順で、層間絶縁膜 9 上に振動子電極 1 1 および配線 1 5 を形成するまでを行う。

その後、犠牲層 1 0 を除去する前に、第 1 2 A 図に示すように、振動子電極 1 1 および配線 1 5 を覆う状態で、層間絶縁膜 9 上に絶縁膜 5 1 を形成する。この絶縁膜 5 1 は、後に行われる犠牲層 1 0 のエッチング除去に対してエッチング耐性を有する絶縁性材料からなることとし、ここでは窒化シリコンからなる絶縁膜 5 1 を形成することとする。

次に、第 1 2 B 図に示すように、層間絶縁膜 9 の第 1 孔パターン 9 a に重ねて、絶縁膜 5 1 に第 2 孔パターン 5 1 a を形成する。その後、振動子電極 1 1、層間絶縁膜 9、出力電極 7 および絶縁膜 5 1 に対して選択的に犠牲層 1 0 をエッチング除去する。この際、バッファードフッ酸を用いたウェットエッチングを行うことで、振動子電極 1 1 下の酸化シリコンからなる犠牲層 1 0 を確実に除去する。

これにより、第 1 1 図に示したように、振動子電極 1 1 の下部に犠牲層を除去してなる空間部 A を形成すると共に、第 1 孔パターン 9 a 底部の出力電極 7 を露出させる。そして、第 1 孔パターン 9 a 内を空間部 A としてこの上部を横切るように、層間絶縁膜 9 上に帯状の振動子電極 1 1 を設けてなるマイクロマシン 5 0 を得る。

以上説明した構成の第5実施形態のマイクロマシン50であっても、孔パターン9a内を空間部Aとして、この上部を塞ぐように振動子電極11が配置されており、また振動子電極11のビーム（振動部）11aの側面が孔パターン9aの側壁部分に支持された状態となっている。しかも、振動子電極11における振動部11aの両脇部分が、層間絶縁膜9とこの上部に設けられた絶縁膜51との間に挟持されているため、第1実施形態と比較して、さらに振動子電極11の支持が確実になる。したがって、第1実施形態よりもさらに確実に、Q値が高く、かつ周波数帯域のより高い高周波フィルタを実現することが可能になる。

#### 10 <第6実施形態>

第13図は第6実施形態のマイクロマシンの構成を示す断面図である。この図に示す第6実施形態のマイクロマシン60は、第11図を用いて説明した第5実施形態のマイクロマシンの変形例である。本第6実施形態のマイクロマシン60と、第11図を用いて説明したマイクロマシンとの異なるところは、振動子電極61の構成にあり、他の構成は同様であることとする。

すなわち、このマイクロマシン60においては、振動子電極61が、出力電極7側に向かって凹状となる部分がなく、その振動部61aも含めて平坦な形状で構成されている。そして、振動子電極61における振動部61aの両脇部分が、層間絶縁膜9とこの上部の絶縁膜51との間に挟持されている。また、配線15も、層間絶縁膜9と絶縁膜51との間に挟持される。

このような構成の振動子電極61を備えたマイクロマシン60を製造する場合には、第1実施形態のマイクロマシンの製造方法において、第2D図を用いて説明した犠牲層10を形成する工程で、孔パターン9a



と同じ高さの犠牲層 10 を形成し、その後は第 5 実施形態と同様の手順を行うと言った方法が採用される。

以上、第 13 図を用いて説明した構成の第 6 実施形態のマイクロマシン 60 においては、孔パターン 9 a 内を空間部 A として、この上部を横切るように振動子電極 61 が配置されている。このため、第 1 実施形態と同様に、特定の周波数の電圧を印可して振動子電極 11 を振動させた場合、孔パターン 9 a 上を横切る振動子電極 61 部分が振動し、この部分が振動子電極 61 の振動部 61 a となる。したがって、孔パターン 9 a の大きさによって、振動部 61 a の長さ（ビーム長 L）が設定されることになる。

したがって、第 1 実施形態で説明したように、ビーム長 L の微細化と、これによる高周波化の達成が可能となると共に、高周波化を目的としてビーム長 L を微細化した場合であっても、出力を維持することが可能になる。

そして特に、本第 6 実施形態の構成のマイクロマシン 60 においては、第 5 実施形態で説明したと同様に、振動子電極 61 の両端部、すなわち振動部 61 a を支持するアンカー部分を、層間絶縁膜 9 とこの上部に設けられた絶縁膜 51 との間に挟持させたことで、層間絶縁膜 9 と絶縁膜 51 とで確実に振動子電極 61 を支持することができ、振動部のみを振動に寄与させることが可能になる。この結果、所定周波数の電圧を印可して振動子電極 61 を振動させた場合、ビーム（振動部）61 a のみが振動に関与して振動することになる。したがって、固有振動周波数が、上述した式（1）を満たす理論上の値（振動部の長さ L の二乗に反比例した値）により近くなる。このことから、微細化による高周波化の達成が容易になる。

ここで、先の第4図には、第6実施形態のマイクロマシン60における、固有振動数のビーム長 $L$ 依存性のシミュレーション結果を合わせて示した。この図に示すように、第6実施形態のマイクロマシン60においては、固有振動数のビーム長依存性が、上述した式(1)を満たす理論上の値(Theory)により近くなり、微細化による高周波化の達成が容易になることが確認された。

尚、上述した第6実施形態においても、振動子電極61は、その両端部に線幅の大きな部分が設けられた形状であっても良く、これによりビーム(振動部)61aの支持を確実にし、固有振動周波数をさらに上昇させることが可能である。

また、上述した第3-第6実施形態は、第2実施形態と組み合わせ、各振動子電極によって孔パターンを塞ぐ様にしても良い。このようにすることで、各第3-第6実施形態の効果に加え、さらに振動子電極の支持を確実にして固有振動周波数の向上を図ることが可能になる。

以上説明したように本発明のマイクロマシンおよびその製造方法によれば、振動子電極における振動部の長さ(ビーム長)を出力電極の幅よりも短くでき、しかも振動部の長さに対して出力電極と振動子電極との間の容量を大きくすることが可能になると共に、層間絶縁膜に対する振動子電極の支持を確実にすることが可能になる。したがって、ビーム長の微細化が可能になるだけでなく、固有振動周波数を理論値に近づけられるため高周波化の達成が容易になる。この結果、Q値が高くかつ周波数帯域のより高い高周波フィルタを実現することが可能になる。

## 請求の範囲

1. 基板上にパターン形成された出力電極と、  
前記基板を覆う状態で設けられると共に前記出力電極を底部とした孔  
5 パターンを備えてなる層間絶縁膜と、  
前記孔パターン内を空間部としてこの上部を横切るように前記層間絶縁膜上に設けられた帯状の振動子電極とを備えたマイクロマシンにおいて、  
前記振動子電極は、前記孔パターンの側壁に沿って当該孔パターン側  
10 に凹状に設けられている  
ことを特徴とするマイクロマシン。
2. 請求の範囲第1項記載のマイクロマシンにおいて、  
前記振動子電極の前記孔パターン側に凹状となる部分の表面は、前記  
層間絶縁膜の表面よりも低く設けられている  
15 ことを特徴とするマイクロマシン。
3. 請求の範囲第1項記載のマイクロマシンにおいて、  
前記孔パターンの両脇に位置する前記振動子電極の両端部分が、前記  
層間絶縁膜と、当該層間絶縁膜上に設けられた絶縁膜との間に挟持され  
20 ている  
ことを特徴とするマイクロマシン。
4. 請求の範囲第1項記載のマイクロマシンにおいて、  
前記振動子電極は、前記孔パターンを塞ぐ状態で配置されると共に、  
当該孔パターン内の空間部に連通する孔部を備えている  
ことを特徴とするマイクロマシン。
- 25 5. 請求の範囲第1項記載のマイクロマシンにおいて、  
前記出力電極は、前記層間絶縁膜に埋め込まれている

ことを特徴とするマイクロマシン。

6. 基板上にパターン形成された出力電極と、

前記基板を覆う状態で設けられると共に前記出力電極を底部とした孔パターンを備えてなる層間絶縁膜と、

5 前記孔パターン内を空間部としてこの上部を横切るように前記層間絶縁膜上に設けられた帯状の振動子電極とを備えたマイクロマシンにおいて、

前記孔パターンの両脇に位置する前記振動子電極の両端部分が、前記層間絶縁膜と、当該層間絶縁膜上に設けられた絶縁膜との間に挟持され

10 ている

ことを特徴とするマイクロマシン。

7. 請求の範囲第6項記載のマイクロマシンにおいて、

前記振動子電極は、前記孔パターンを塞ぐ状態で配置されると共に、当該孔パターンの空間部に連通する孔部を備えている

15 ことを特徴とするマイクロマシン。

8. 請求の範囲第6項記載のマイクロマシンにおいて、

前記出力電極は、前記層間絶縁膜に埋め込まれている

ことを特徴とするマイクロマシン。

9. 基板上に出力電極をパターン形成すると共に、当該出力電極を底部とした孔パターンを備えた層間絶縁膜を前記基板上に形成する第1工程と、

前記孔パターンの底部に前記層間絶縁膜の表面よりも低い表面高さで犠牲層を形成し、当該犠牲層によって当該孔パターンの底部の出力電極表面を覆う第2工程と、

25 前記犠牲層の一部を露出させた状態で当該犠牲層上を横切る帯状の振動子電極を、前記孔パターンの内壁に沿って当該孔パターン側に凹状と

なるように前記犠牲層および前記層間絶縁膜上にパターン形成する第3工程と、

前記孔パターン内の犠牲層を選択的に除去することで、前記出力電極と前記振動子電極との間に空間部を設ける第4工程とを行う

5      ことを特徴とするマイクロマシンの製造方法。

10      10. 基板上に出力電極をパターン形成すると共に、当該出力電極を底部とした第1孔パターンを備えた層間絶縁膜を前記基板上に形成する第1工程と、

前記第1孔パターン底部の出力電極表面を犠牲層で覆う第2工程と、

10      前記犠牲層の一部を露出させた状態で当該犠牲層上を横切る帯状の振動子電極を、前記犠牲層および前記層間絶縁膜上にパターン形成する第3工程と、

前記振動子電極を覆う状態で前記層間絶縁膜上に絶縁膜を形成し、当該絶縁膜に前記振動子電極および前記犠牲層を露出する第2孔パターン

15      を形成する第4工程と、

前記第2孔パターンを介して前記第1孔パターン内の犠牲層を選択的に除去することで、前記出力電極と前記振動子電極との間に空間部を設ける第5工程とを行う

ことを特徴とするマイクロマシンの製造方法。



2/16

Fig.2A

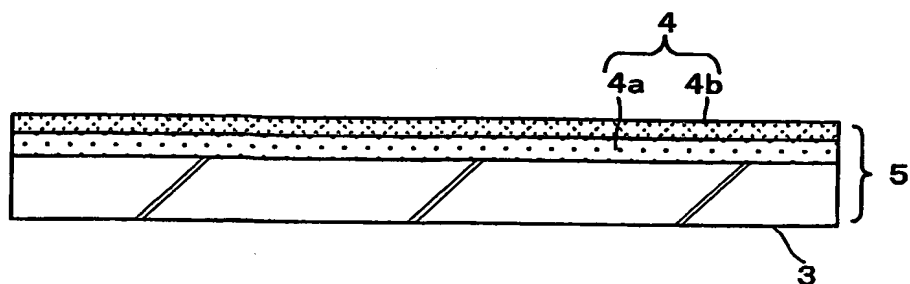


Fig.2B

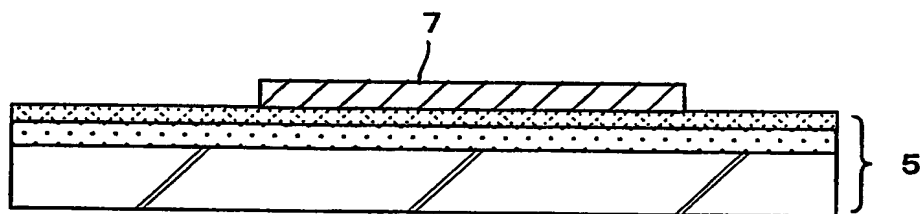


Fig.2C

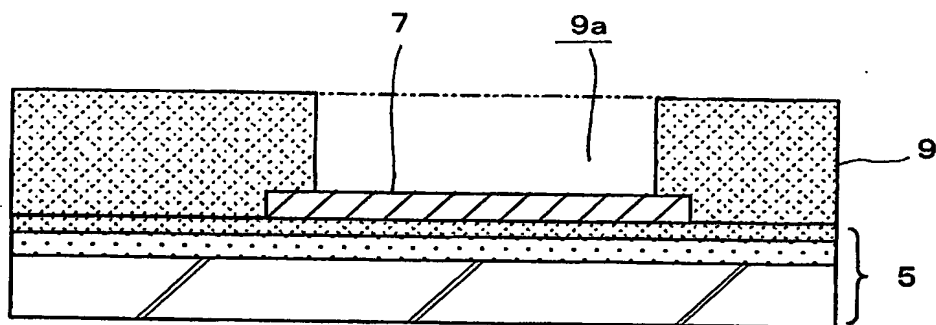
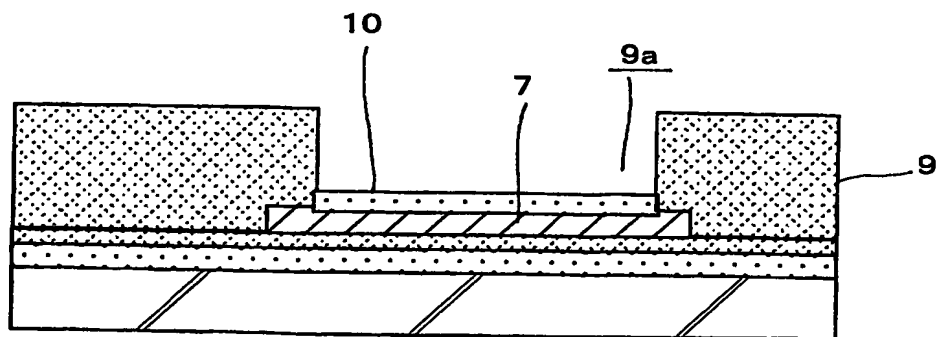


Fig.2D



3/16

Fig.3A

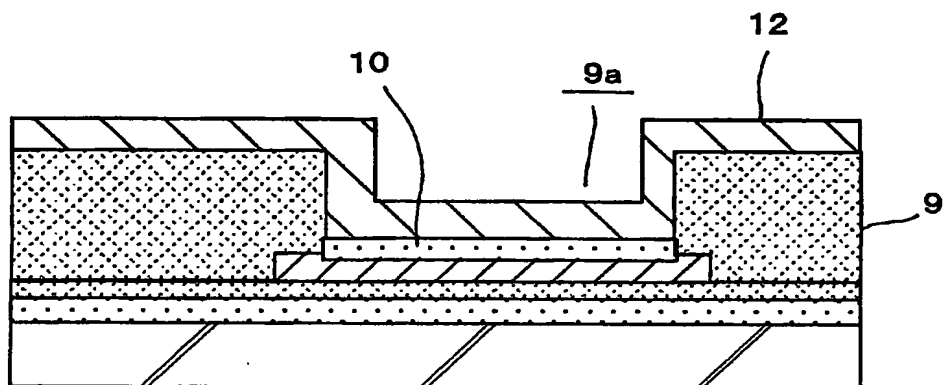


Fig.3B

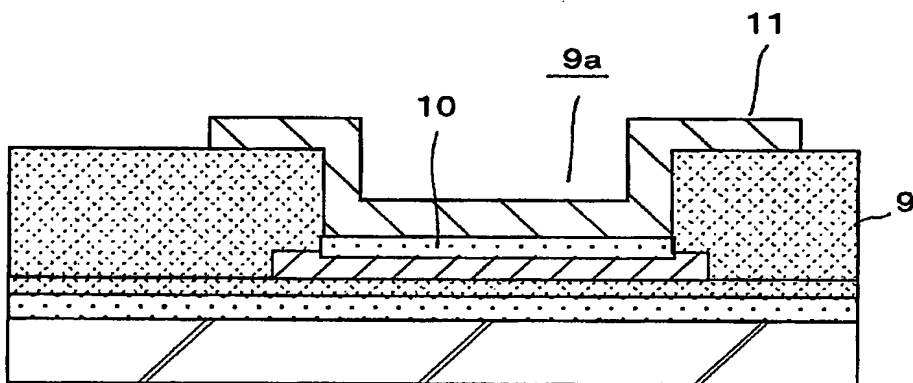
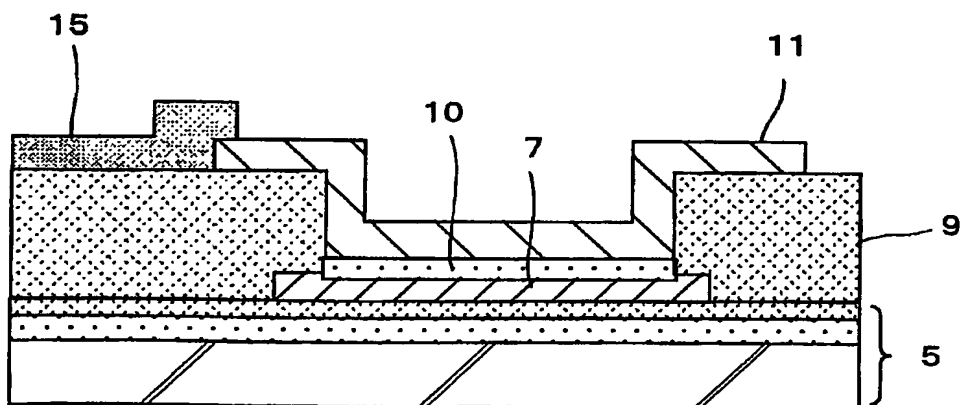


Fig.3C





4/16

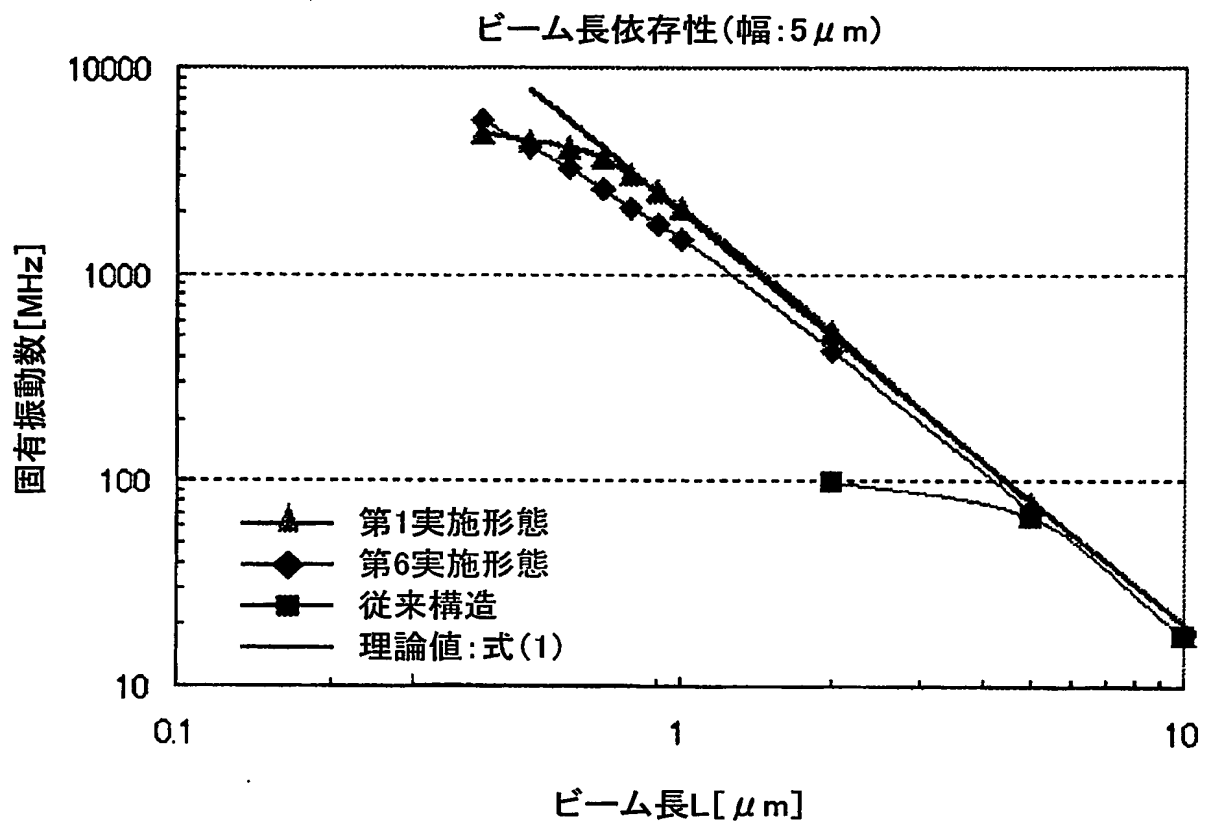


Fig.4

Fig.5A

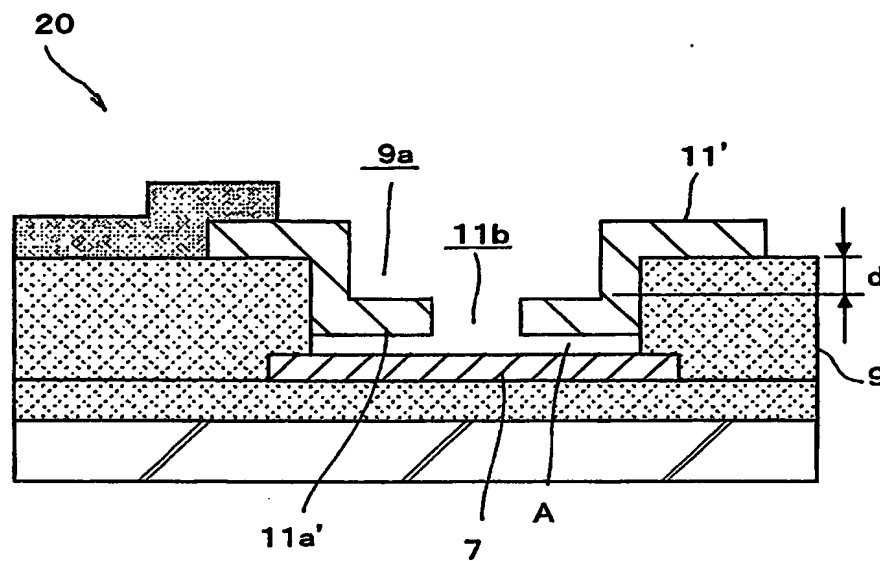
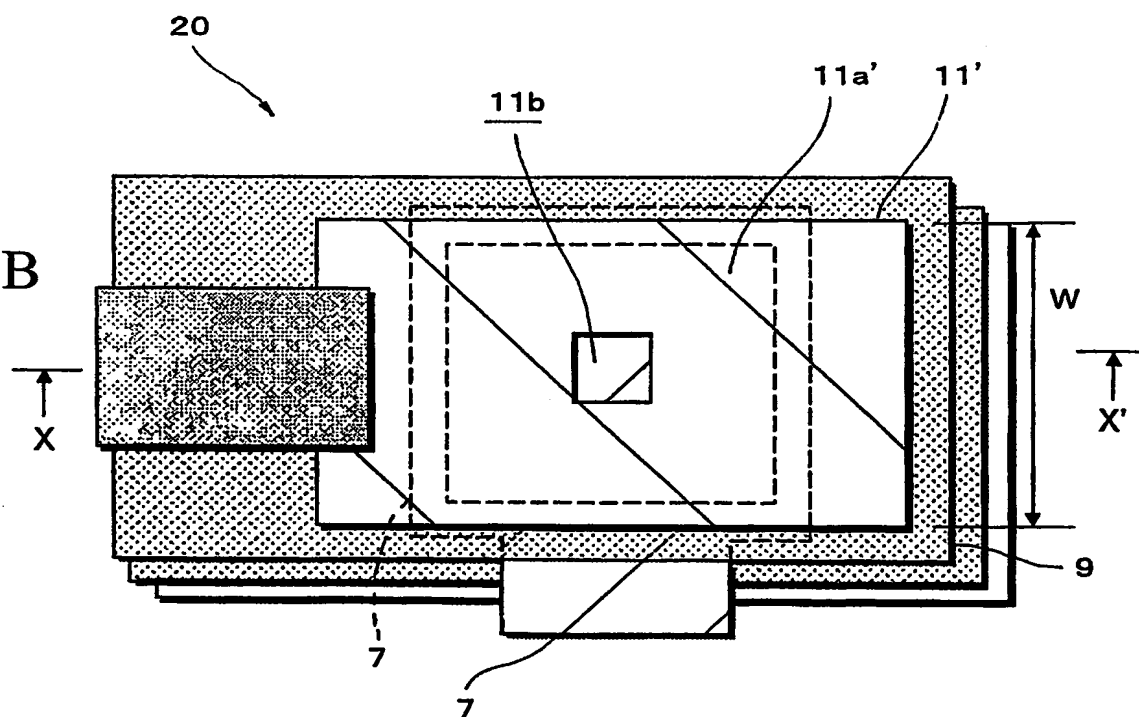


Fig.5B



6/16

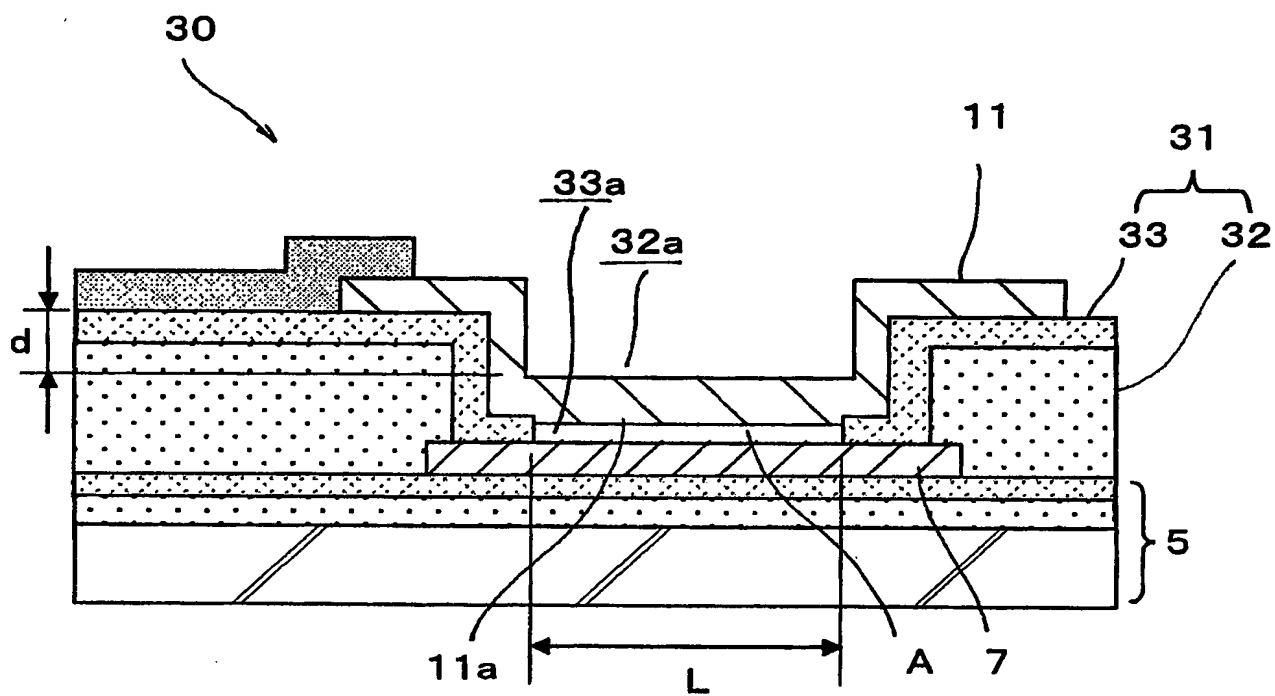


Fig.6

7/16

Fig.7A

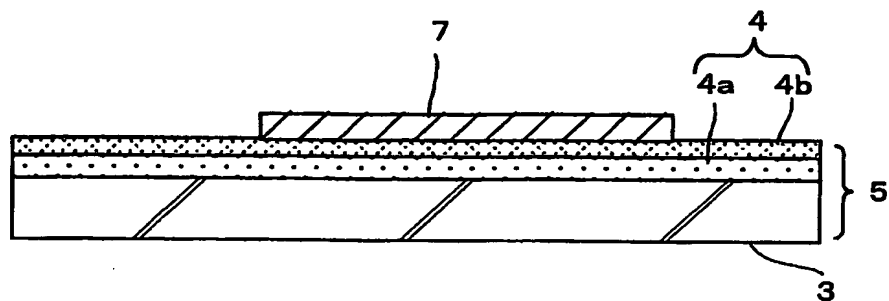


Fig.7B

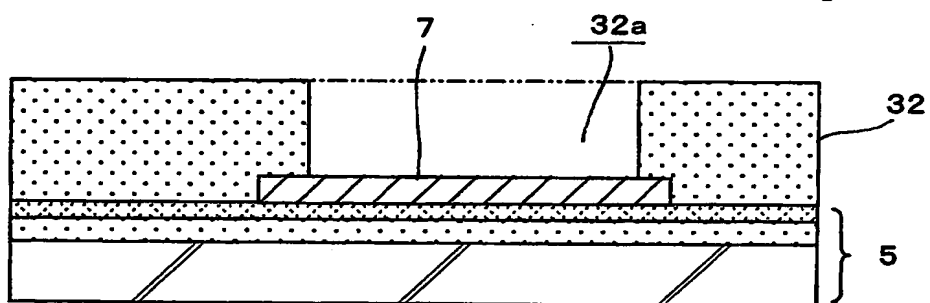


Fig.7C

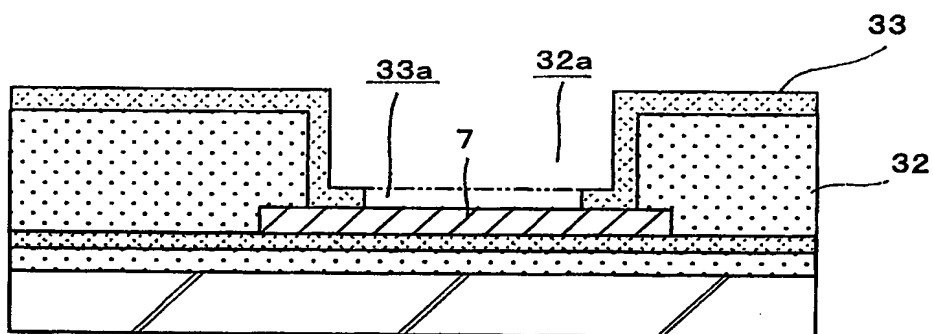
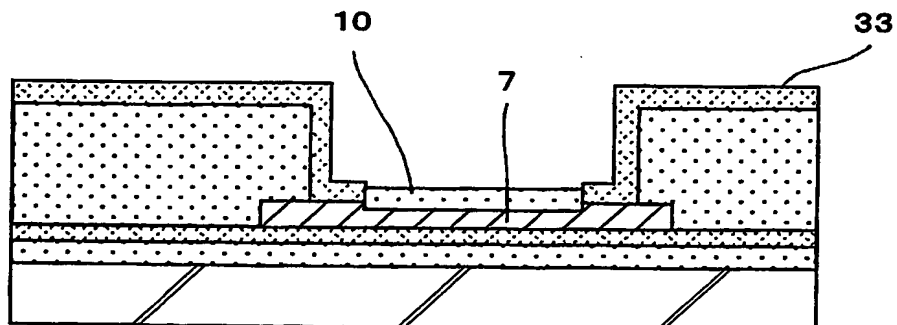


Fig.7D



8/16

Fig.8A

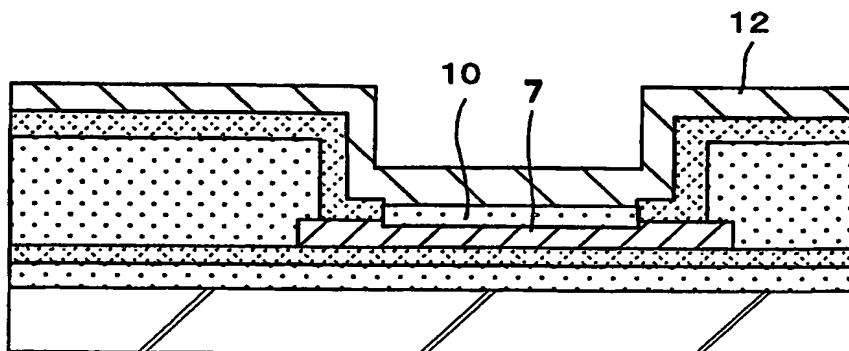


Fig.8B

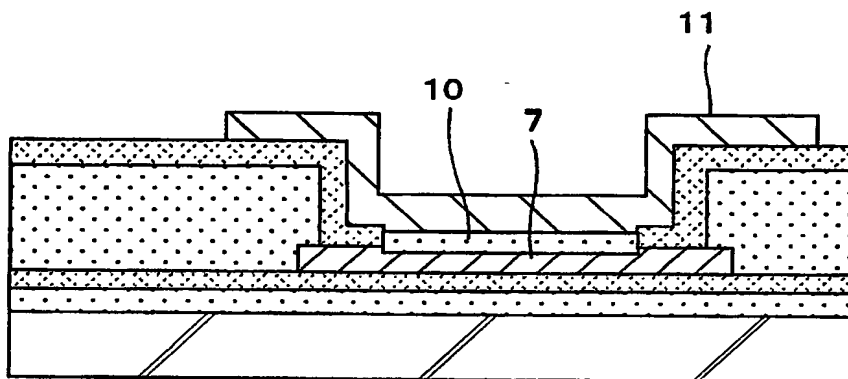
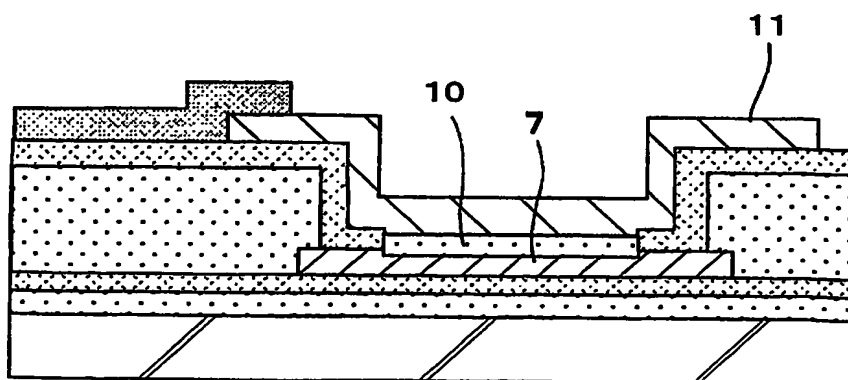
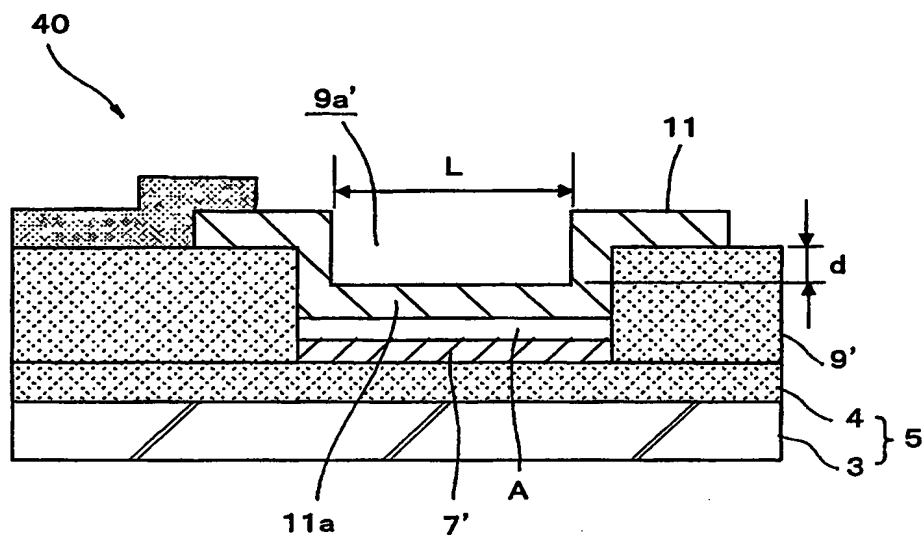


Fig.8C

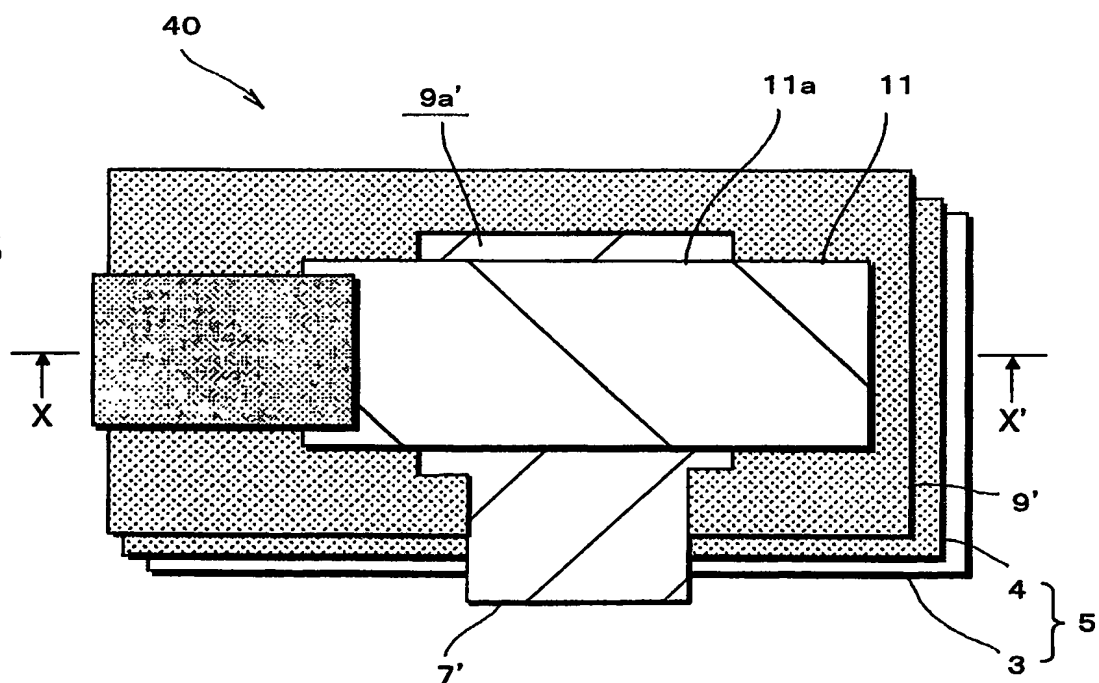


9/16

**Fig.9A**



**Fig.9B**



10/16

Fig.10A

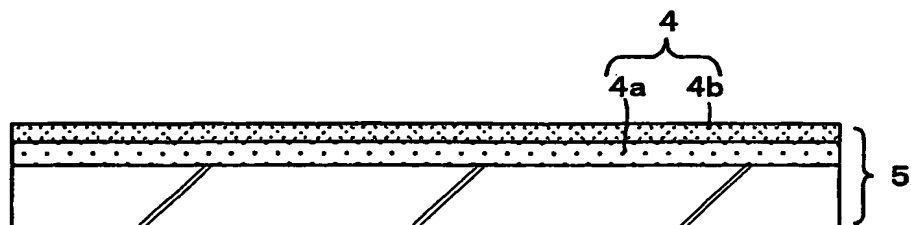


Fig.10B

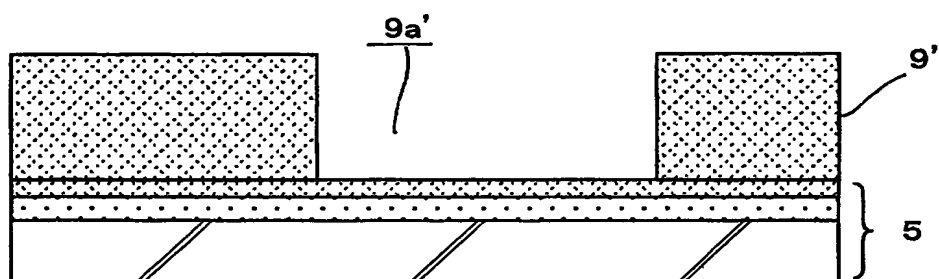


Fig.10C

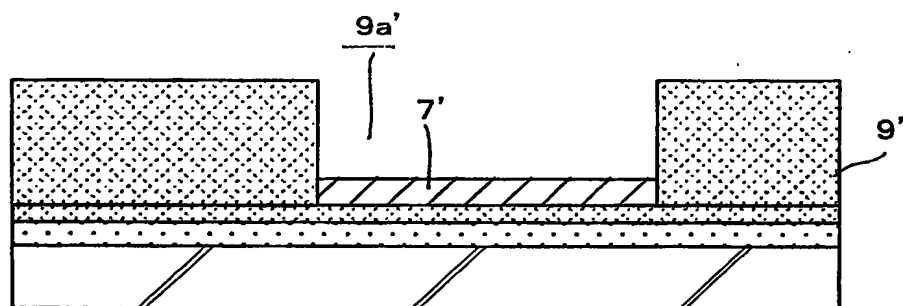
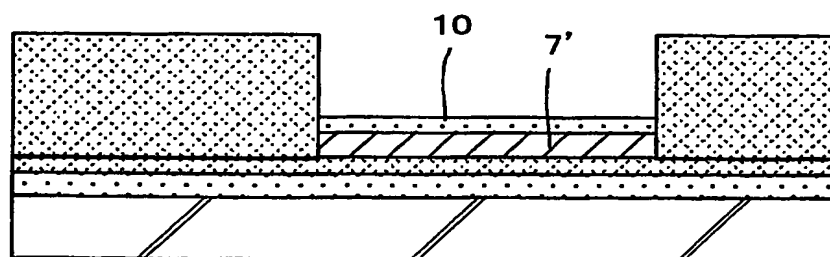


Fig.10D



11/16

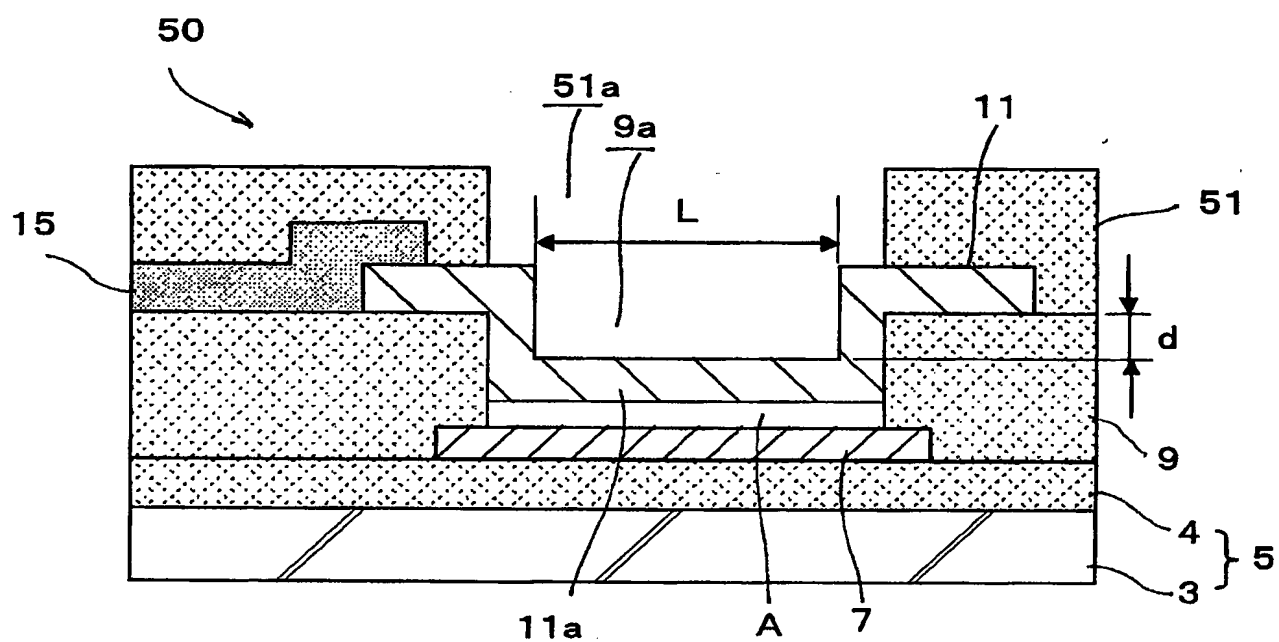


Fig.11



12/16

Fig.12A

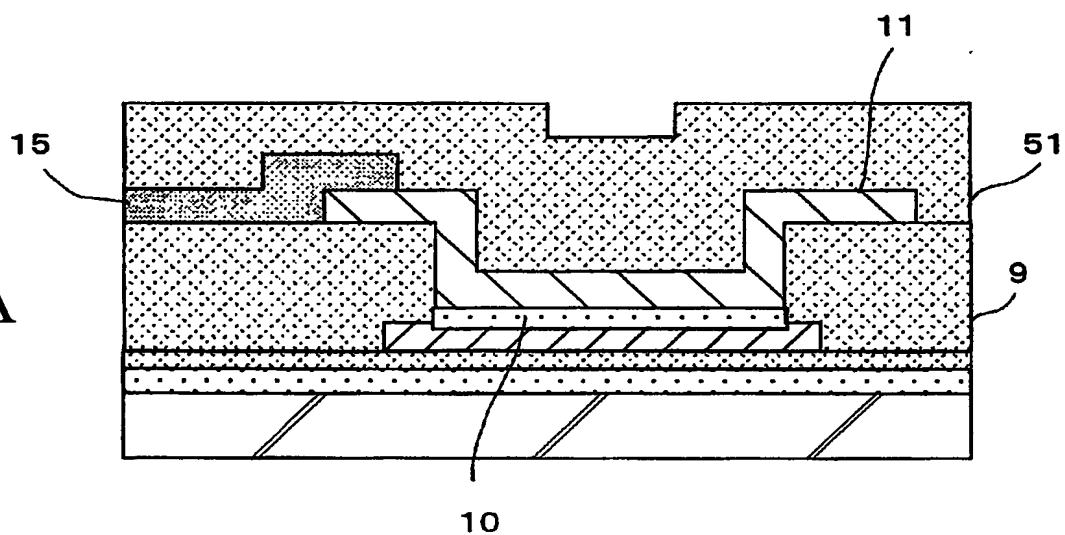
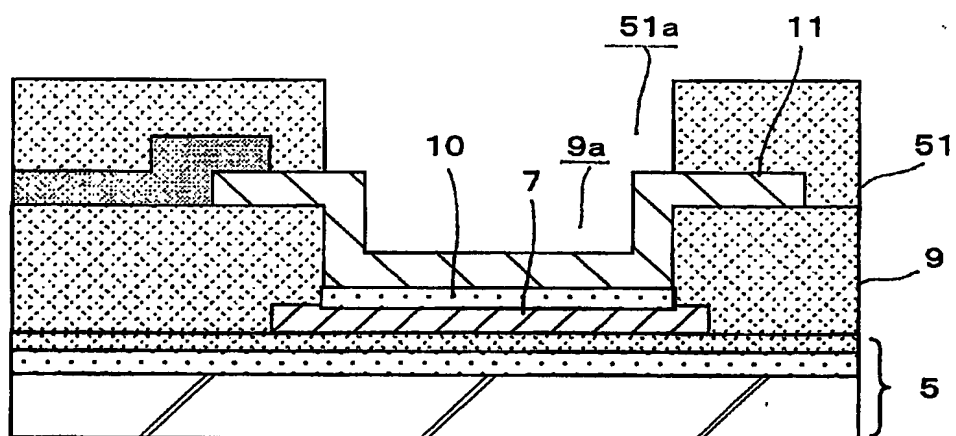


Fig.12B



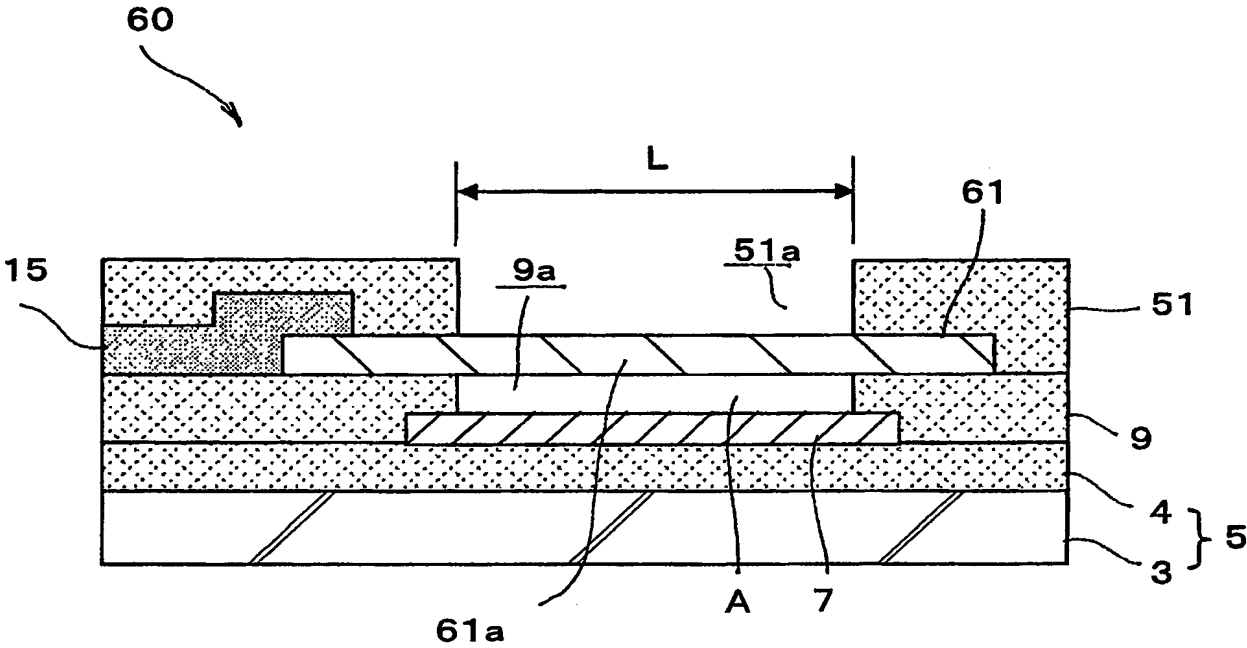


Fig.13

14/16

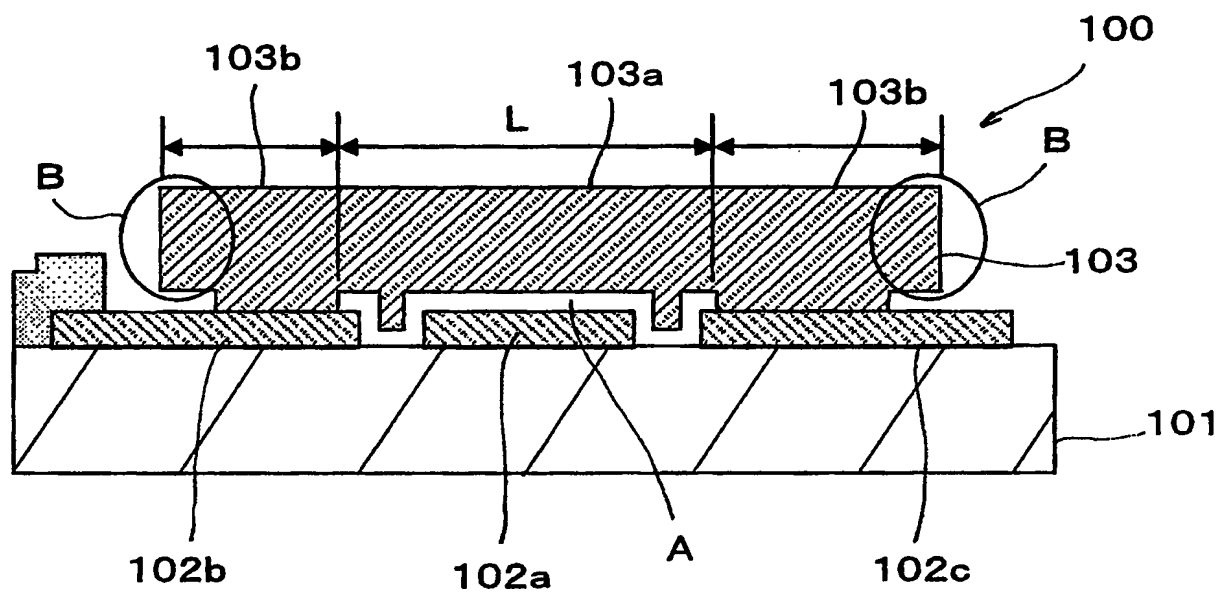


Fig.14

15/16

Fig.15A

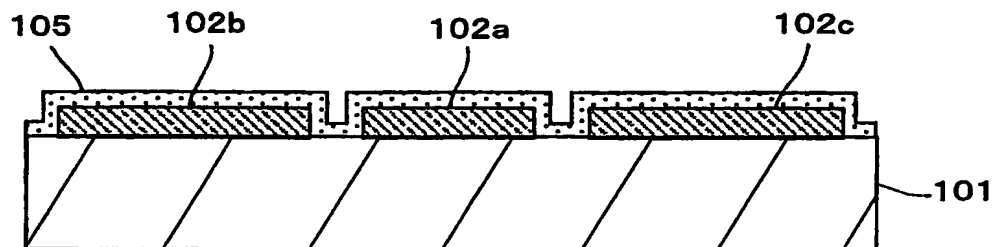


Fig.15B

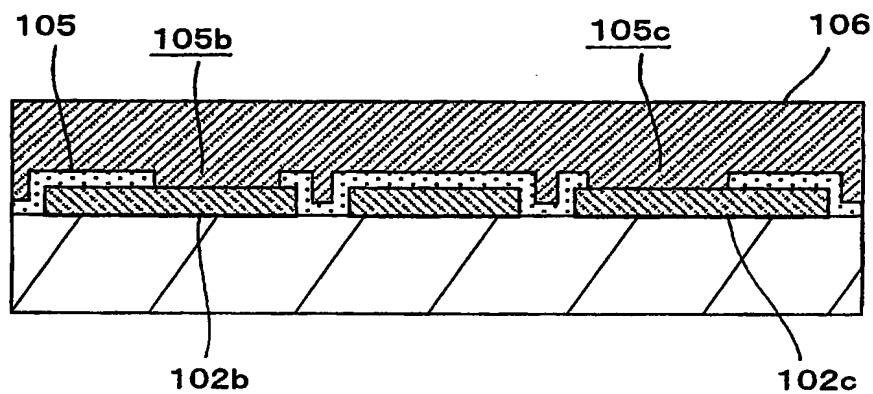
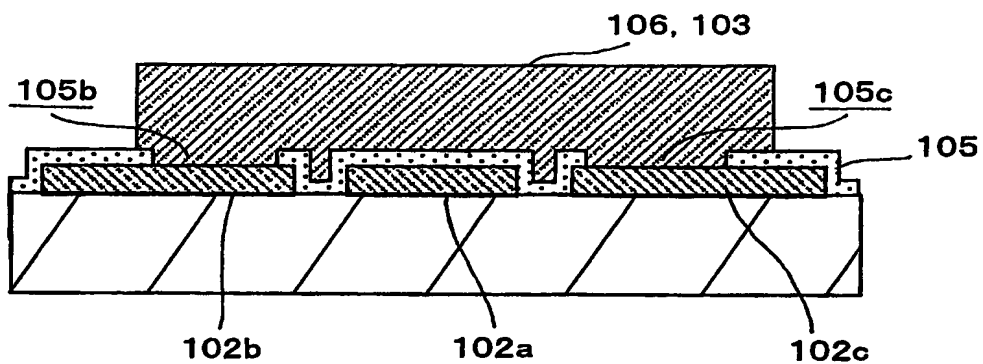


Fig.15C



16/16

BEST AVAILABLE COPY

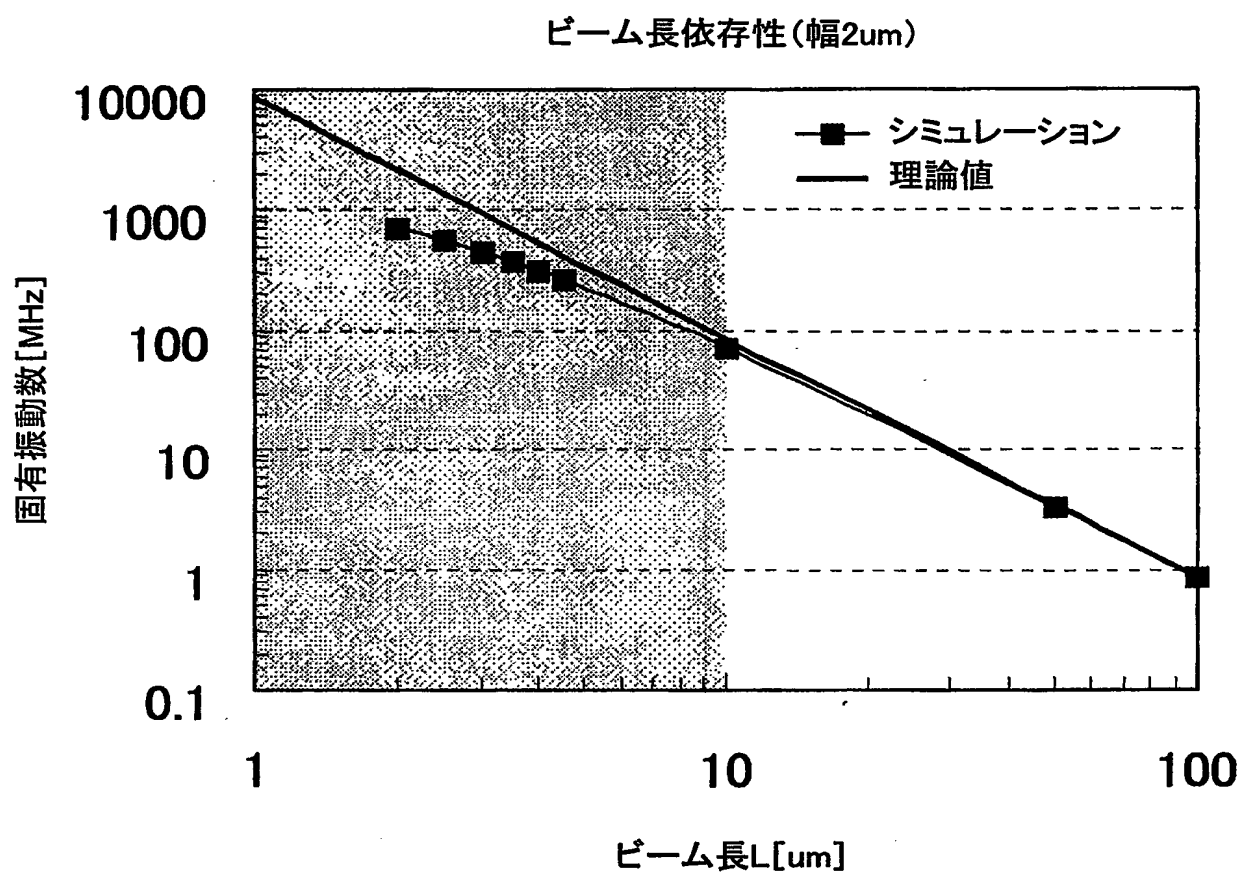


Fig.16

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/14976

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> B81B3/00, B81C1/00, H03H9/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> B81B3/00, B81C1/00, H03H9/24

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1100196 A2 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.), 16 May, 2001 (16.05.01), Full text & JP 2001-203558 A & JP 2001-211053 A & US 6441539 B1	1-10
A	JP 2000-111347 A (Aisin Seiki Co., Ltd.), 18 April, 2000 (18.04.00), Full text (Family: none)	1-10
A	JP 11-340777 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 10 December, 1999 (10.12.99), Full text (Family: none)	1-10

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
---	--

Date of the actual completion of the international search  
24 February, 2004 (24.02.04)

Date of mailing of the international search report  
09 March, 2004 (09.03.04)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP03/14976

**C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 10-154820 A (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.), 09 June, 1998 (09.06.98), Full text (Family: none)	1-10
A	JP 10-111189 A (Yokogawa Electric Corp.), 28 April, 1998 (28.04.98), Full text (Family: none)	1-10

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> B81B3/00, B81C1/00, H03H9/24

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> B81B3/00, B81C1/00, H03H9/24

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年  
 日本国公開実用新案公報 1971-2004年  
 日本国登録実用新案公報 1994-2004年  
 日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	EP 1100196 A2 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) 2001. 05. 16, 全文 & JP 2001-203558 A & JP 2001-211053 A & US 6441539 B1	1-10
A	JP 2000-111347 A (アイシン精機株式会社) 2000. 04. 18, 全文 (ファミリーなし)	1-10
A	JP 11-340777 A (松下電器産業株式会社) 1999. 12. 10, 全文 (ファミリーなし)	1-10
A	JP 10-154820 A (株式会社村田製作所) 1998. 06. 09, 全文 (ファミリーなし)	1-10

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 02. 2004

国際調査報告の発送日

09. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

三宅 達



3P 2919

電話番号 03-3581-1101 内線 3362



## C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 10-111189 A (横河電機株式会社) 1998. 04. 28, 全文 (ファミリーなし)	1-10